

## EV Group revolutionizes 3D integration from advanced packaging to transistor scaling with NanoCleave™ layer release technology – September 22, 2022

EVG introduced NanoCleave<sup>™</sup>, a revolutionary layer release technology for silicon that enables ultra-thin layer stacking for front-end processing, including advanced logic, memory and power device formation, as well as semiconductor advanced packaging. In 3D integration, carrier technologies for thin-wafer processing are key to enabling higher performance systems with increasing interconnection bandwidth. Glass carriers have become an established method for building up device layers through temporary bonding with organic adhesives, using an ultraviolet (UV) wavelength laser to dissolve the adhesives and release the device layers, which are subsequently permanently bonded onto the final product wafer.



NanoCleave' 기술은 정단 분지, 에도리, 전략 반도 제 프한트 언드 공항은 물론 정단 반드제 파키칭에 호박할 레이어 정충을 가능하게 된다.



그 얼과 NanoCeste는 물일과 작구성 확인처음 사용하는 전대로 확인하 점열 패키질(60ME)이나 10 Stacking KIBO SCS을 위한 한다표가 닿은 철단 라키질 충청에서 설립은 확인히 처하여 사용을 가 하여게 한다. 작가고 등 분장에도 되울이 가능해 30 KD와 30 순자 집학 여름리적이번에서 전혀 새 또는 공전 등로우를 가능하게 된다.

이는 설리론 캐리어 상의 조박형 레이어까지도 하이보리도와 유한 본당이 가능해 30와 이중 집작에 되신을 가격다구고, 자세대 로런지스터 합력화 설계에서 필요한 런이어 이숙(layer transfer)를 가끔하 게 한다는 것이다.

3D 철적에서는 점점 더 늘어지는 인터워먹던 다약복으로 늘은 수준의 고성능 시스템을 구점할 수 있도록 박형 웨이크 공장을 위한 커리에 기술이 출소되다. 이를 위해 기준의 우루 기업은 우리 카리 어를 사용하고 있다.

해당 기법은 유기 접착적을 가지고 입시 본당을 해서 다하이스 레이어를 형성한 다음, 자와입니자) 구 당 레이저를 사용해서 참석하를 통해 시키고 디바이스 레이어를 합리고 한 후 회장 문성을 됐이고 상에 삼구적으로 본당한다.

그러나 유리 가란은 일리를 위우로 설치된 반도에 제조 장비를 사용해서 저리하기가 까다롭고 유리 웨이파를 저러할 수 있도록 업그러이도를 하려면 비용이 많이 든다. 뿐만 아니라 유기될 결작에는 통 상적으로 500°C 이하의 처리 온도로 제한되므로 로공령에 사용하기에 한제가 있다.

반영 NanoCleane 기술은 우기 합리즈 적이어를 사용적서 실리콘 처리어를 사용할 수 있어 이런 준도 전체와 유리 처리어의 포함성 이슈를 피할 수 있다. 뿐만 아니라 의 적이자를 사용하서 나느미터 청 철도로 클리성이 가능하므로 기존 공접을 변경하지 않고서 조박될 디바이스 웨이피를 처리할 수 있

이렇게 한동어진 조박형 디바이스 레이어를 작용하면 더 용은 대학복의 한타커네츠를 구멍할 수 있 오면, 저세대 고양한 시스템을 위한 다이를 설계 및 세윤화하기 위한 세르운 기회을 만들 수 있다고 업체 관계자는 당조했다.

트런지스터 로드템이 Svm 이하 노드로 전화함에 따라 매합함 전원 해일, 후면 전원 공급 네트워크, 상포성 METICPET, 20 원자 제념 같은 새로운 아카텍처와 설계 확신이 필요하였다.

이런 요즘 기법들에는 구히 많은 소재와 레이어 이술이 요구된다. 실리존 캐리어와 무기 둘러즈 레이 어는 한 공정 제조 용로우를 위한 프로세스 행결성, 소재 호환성, 받은 처리 온도 요간을 지원한다.

하지만 지금까지 살라온 카리이는 그라인당 먼다. 나각 공장을 가쳐서 완벽하게 적거되어 하는데, 이 는 작업 중한 디바이스 레이어의 표면에 마이크를 대의 자이를 유절하므로, 없단 로단지스터 노드의 박형 레이어 작용에 사용하기에는 희합하지 않다.

EVG의 서로운 NanoCleane 가열은 또 하이저와 무기철 철리즈 소재를 사용하므로 설리폰 상에서 나 노미터 영토도로 하이지 다른당이 가능하다.

이는 철단 라치정 공장에서 유리 기단을 사용할 필요가 않도록 해 온도 현재와 유리 차리어 포함성 문제을 피할 수 있어 해주면, 가운 공장을 변경하지 않고도 한 공장에서 캐리어를 통해 조박받은 차 있수 마이크를 대 이하는레이어를 마습할 수 있다.

이렇게 나고미터 대의 정철도를 가득하는 EVS와 새로운 프로셔스는 더 없은 디바이스 헤이어와 돼 키지를 철로로 하는 정단 반도적 디바이스 로드답의 유구를 목록하고 장상된 이를 친탁을 가능하게 하여 박형 레이어 이송 및 유리 기반을 사용할 필요가 없어 운전비용을 점합할 수 있게 해준다.

EV Goupiù 기열 이사인 등 집도나paul Lindrierit는 '번도해 공항 노도를 축소하기가 잘수록 더 복합 하고 어려워지고 있다. 공항 노도를 축소하려면 프로셔스 하용공가 또한 항칭 더 들어롭기 때문이다. 업계에서는 더 높은 집회되고 더 높은 디바이스 성능을 일었다기 위한 세분은 프로셔스와 집회 방법 를 필요로 한다. 우리의 NacoCesse 취이에 참리고 기울은 박형 취이어와 다이 작품을 통한 반도체 고기 축소에 되어서 제공 제한자가 될 것이며, 반도제 업계에서 가장 입박이 심한 요구 사항들을 해 당황 합지학을 가지고 있다"라고 잘한다.

이어 TrianoClesse는 표준 설리준 웨이퍼 및 웨이퍼 공장들과 포함되는 유전하고 변충성이 뛰어난 테 이어 합리죠 기량을 통해 우리 고객들이 집한 디비이스 및 테키징 포트함을 설한할 수 있지 기원할 곳이며, 고대용은 이 기술을 자신유의 기준 전에 지체없이 통합하고 시간과 배응을 절심할 수 있을 것이다.파크 맛뿐였다.

EVGB NanoCleate 가열은 설리폰 웨이파의 뒷면을 더 먹이저에 노출시킨다. 이 라이자는 설리폰을 루그러는 고유의 과장을 사용한다. 프로 중국 등장을 통해서 설리로 스펙에 따라 구국된 독리 조 레이어가 이 옷장을 좋수해 사한에 정칭하게 지정된 레이어나 먼저으로 설리폰을 본리시킨다.

무기점 합리즈 먹이어를 사용받으로써 좋다 정말하고 함은 테이어를 사용할 수 있다.추가 합의적을 사용할 때 수 아이크를 대한한 것에 배해 수 나노미에 대로 할아함. 뿐만 아니라 우기를 들하고 하여 에는 교은 공항,레더 1000억(과 또한 가능하므로, 여지역시, 중한, 어떻을 같아 유기 합학적을 수술한 수 있는 많은 새로운 전응할 어울로게이트들로 취이어 이상을 가능하게 한다고 입체 주은 전한다.

http://www.bizwnews.com/news/articleView.html?idxno=42234